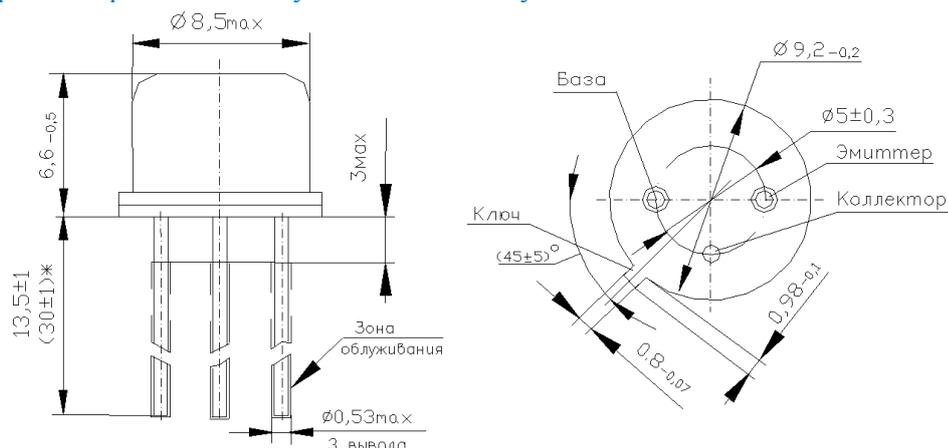




## Транзисторы 2Т603И/ИУ

Кремниевые эпитаксиально-планарные п-р-п импульсные высокочастотные транзисторы 2Т603И/ИУ в металлостеклянном корпусе КТ-2, предназначены для работы в схемах аппаратуры специального назначения.

Транзисторы соответствуют техническим условиям АЕЯР.432140.400 ТУ.



Масса транзистора не более 1,75 г

Т а б л и ц а 1 - Электрические параметры транзисторов при приемке и поставке (Т=25°С)

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма	
		не менее	не более
Обратный ток коллектора ( $U_{КБ}=30В$ ), мкА	$I_{КБ0}$	-	3
Обратный ток эмиттера ( $U_{ЭБ}=4В$ ), мкА	$I_{ЭБ0}$	-	3
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте, ( $U_{КЭ}=10В$ , $I_{К}=30мА$ , $f=100МГц$ )	$ h_{21Э} $	2	-
Емкость коллекторного перехода ( $U_{КБ}=10В$ , $f=5МГц$ ), пФ	$C_{К}$	-	15
Емкость эмиттерного перехода ( $U_{ЭБ}=0В$ , $f=5МГц$ ), пФ	$C_{Э}$	-	40
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте ( $U_{КЭ}=10В$ , $I_{К}=30мА$ , $f=5МГц$ ), нс	$\tau_{к}$	-	400
Статический коэффициент передачи тока ( $U_{КБ}=2В$ , $I_{Э}=350мА$ , $f=50Гц$ )	$h_{21Э}$	20	210
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ( $I_{К}=350мА$ , $I_{Б}=50мА$ ), В	$U_{КЭнас}$	-	1,2
Напряжение насыщения база-эмиттер ( $I_{К}=350мА$ , $I_{Б}=50мА$ ), В	$U_{БЭнас}$	-	1,3
Время рассасывания ( $I_{К}=150мА$ , $I_{Б1}=-I_{Б2}=15мА$ , $\tau_{п}\leq 30мкс$ , $Q\geq 50$ ), нс	$t_{рас}$	-	70

Т а б л и ц а 2 - Предельно допустимые значения параметров электрических режимов эксплуатации

Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение параметра	Норма
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	$U_{КБ макс}$	30
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер (при $R_{бэ}\leq 1кОм$ ), В	$U_{КЭ макс}$	30
Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер (при $R_{бэ}\leq 1кОм$ , $\tau_{п}\leq 10мкс$ , $Q\geq 10$ ), В	$U_{КЭ и макс}$	45
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$U_{Эб макс}$	4
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, мА	$I_{к макс}$	300
Максимально допустимый импульсный ток коллектора ( $\tau_{п}\leq 10мкс$ , $Q\geq 10$ ), мА	$I_{к и макс}$	600
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт	$P_{к макс}$	0,5
Максимально допустимая температура перехода, °С	$T_{пер. макс}$	150
Тепловое сопротивление, °С/Вт	$R_{тп-окр. ср.}$	200
Температура окружающей среды, °С	$T_{окр. ср.}$	От минус 60 до 125

Изготовитель:

ОАО «НПП «ЗАВОД ИСКРА»  
432030, г. Ульяновск, проспект Нариманова, 75

тел.: (8422) 46-81-90, факс: (8422) 46-37-46, 46-37-47  
e-mail: [iskra@iptk.ru](mailto:iskra@iptk.ru); Web сайт: [www.zavod-iskra.ru](http://www.zavod-iskra.ru)